

This Page Is Inserted by IFW Operations  
and is not a part of the Official Record

## **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

**IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.**

**As rescanning documents *will not* correct images,  
please do not report the images to the  
Image Problem Mailbox.**

DIALOG(R)File 347:JAPIO  
(c) 1998 JPO & JAPIO. All rts. reserv.

03242326  
LIQUID CRYSTAL ELECTROOPTIC DEVICE

PUB. NO.: 02-217826 [JP 2217826 A]  
PUBLISHED: August 30, 1990 (19900830)  
INVENTOR(s): YAMAZAKI SHUNPEI  
APPLICANT(s): SEMICONDUCTOR ENERGY LAB CO LTD [470730] (A Japanese  
Company or Corporation), JP (Japan)  
APPL. NO.: 01-326553 [JP 89326553]  
FILED: December 15, 1989 (19891215)

#### ABSTRACT

PURPOSE: To enable development even to a liquid crystal display by forming field-effect semiconductor devices IGF, resistances, and capacitors on a substrate, specially, an insulating substrate.

CONSTITUTION: On one electrode 22 which is coupled electrically to a semiconductor 12, the other electrode 24 and one electrode 32 of a 2nd liquid crystal capacitor 31 which is coupled with the electrode 24a are coupled through an opening 25, and a counter electrode 27 made of a transparent electrode is provided corresponding to the electrode 32 by pinching a dielectric of liquid crystal 26. Thus, the IGF capacitors, and resistor or the plane panel of the liquid crystal display as a sandwich structure are provided on the substrate 1 at the same time, they are covered from above so as to prevent light from leaking in a 0 state when the IGFs 10 are irradiated with light from above, and one electrode 3 of a picture element is provided. Consequently, a solid-state display device for a plane television replacing a cathode-ray tube can be manufactured.

## ⑪ 公開特許公報 (A)

平2-217826

⑪ Int. Cl. 3	識別記号	序内整理番号	⑬ 公開 平成2年(1990)8月30日
G 02 F 1/136	500	7370-2H	
G 09 G 3/36		8621-5C	
H 01 L 27/12	A	7514-5F	
29/784			
		8624-5F	H 01 L 29/78 311 A
			審査請求 有 発明の数 1 (全7頁)

⑫ 発明の名称 液晶電気光学装置

⑬ 特 頂 平1-326553

⑭ 出 頂 昭56(1981)1月9日

⑮ 特 頂 昭56-1768の分割

⑯ 発明者 山崎 舜平 神奈川県厚木市長谷398番地 株式会社半導体エネルギー研究所内

⑰ 出 頂 人 株式会社半導体エネルギー研究所 神奈川県厚木市長谷398番地

## 明細書

## 1. 発明の名称

液晶電気光学装置

## 2. 特許請求の範囲

1. 絶縁ゲート型電界効果半導体装置に液晶表示装置と電荷蓄積用キャバシタとが直列に接続された構造であって、前記絶縁ゲート型電界効果半導体装置上に前記液晶表示装置の一方の電極が設けられた液晶電気光学装置。

2. 特許請求の範囲第1項において、液晶表示装置の一方の電極は、絶縁ゲート型電界効果半導体装置へ光が照射されないように設けられたことを特徴とする液晶電気光学装置。

## 3. 発明の詳細な説明

本発明は基板上にたてチャネル型の積層型の絶縁ゲート型半導体装置を設けた液晶電気光学装置に関する。

さらに本発明は基板上の積層型の絶縁ゲート型電界効果半導体装置のソースまたはドレインに連結してキャバシタを有せしめた複合半導体装置を

設けた液晶電気光学装置に関する。

本発明はかかる複合半導体装置をマトリックス構造に基板上に設け、液晶表示型のディスプレイ装置を設けることを特徴としている。

本発明は表面型の固体表示装置を設ける場合、平行なガラス板内に電極を設けてこの電極間に液晶を注入した液晶表示装置が知られている。しかしこの場合この表示部の絵素数は20~200までが限界であり、それ以上とする場合はこの表示部より外にとり出す端子が絵素の数だけ必要となってしまうため全く実用に供することができなかった。このためこの表示部を複数の絵素とし、それをマトリックス構成させ、任意の絵素を制御してオンまたはオフ状態にするにはその絵素に対応した電界効果半導体装置 (IGF) という) を必要としていた。そしてこのIGFに制御信号を与えてそれに対応した絵素をオンまたはオフさせたものである。

この液晶表示部はその等価回路としてキャバシタ (以下Cという) にて示すことができる。この

ため I と C とを例えれば  $2 \times 2$  のマトリックス構成(40)を示したもの第1図に示す。

第1図においてマトリックス(40)はひとつの I C F (10)とひとつの C (31)によりひとつの絵素を構成させている。これを行に(51), (51')とピット線に連結し、他方ゲートを連結して列(41), (41')を設けたものである。

すると、例えれば(51), (41)を"1"とし、(51'), (41')を"0"とすると(1,1)番地のみを選択してオンとし、電気的に C (31)として等価的に示される液晶表示を選択的にオン状態にすることができる。本発明は同一基板上にデコーダ、ドライバーを構成せしめるため、他の绝缘ゲート型半導体装置(50)および他のインバータ(60)、抵抗(70)を同一基板上に設けることを目的としている。

かくすることにより本発明をその設計仕様に基づいて組合せることによりブラウン管に代わる平面テレビ用の固体表示装置を作ることができた。

さらにカリキュレータ用の表示装置は  $10^3 \sim 10^4$  ケの絵素を累いればよく、TV用には  $10^4 \sim 10^5$  個

例え  $10^3 \times 10^3$  個の絵素を同一基板に設け、かつその周辺に必要なデコーダおよびドライバーを同時に形成させた I C F 、インバータ、抵抗を用いて作ればよいことがわかる。

本発明にかかるシステムを作るために必要な積層型の I C F およびそれに液晶表示部を連結させた絵素に関するものである。

第2図は本発明の積層型 I C F のたての断面図およびその製造工程を示したものである。

図面において绝缘基板例えはガラスまたはアルミナ基板上に P+ または N+ 型の導電型を有する第1の半導体(2) (以下単に S 1 という) トンネル電流を流しうる厚さの绝缘または半绝缘膜(3) 第2の真性または N または P 型の半導体(4) (以下単に S 2 という)、第1の半導体と同一導電型を有する第3の半導体(5) (以下単に S 3 という) を積層して設けた。

この半導体は基板上にシランのグロー放電法を利用して室温～500 °C の温度にて設けたもので、非晶質(アモルファス)または半非晶質(セミア

モルファス)構造の珪素半導体を用いている。本発明においてはセミアモルファス半導体(以下 S A S という)を中心として示す。この S A S に関して本発明人の発明になる特許例えは特願昭55-143885(55.10.15出願)(セミアモルファス半導体)、特願昭55-122786(55.9.4出願)(半導体装置)、特願昭55-026388(55.3.3出願)(セミアモルファス半導体)にその詳細な実施例が示されている。

さらに第2図においてフォトリソグラフィー技術により S 3 を選択的に除去し、さらにこの S 3 をマスクとして S 2 を除去した。このフォトエッチングの終点をみるために绝缘または半绝缘膜(以下単に绝缘膜という)(13)は窒化珪素をして設けた。

さらにその厚さは 5 ～ 30 Å のうすさであり、第1の半導体をプラズマ照射にされたアンモニア雰囲気にさらすことにより成就した。次にこの绝缘膜(13)を化学的に除去した後第2図(B)を得た。

この S 3 の上にこの後に形成された绝缘膜をさらに厚く作るため、あらかじめ L P C V D 法(減

圧気相法)により 0.3 ～ 1 μ の厚さに酸化珪素膜を形成しておいてもよい。またこの S 3 上に Mo、W を 0.2 ～ 0.5 μ さらにその上に SiO<sub>2</sub> を 0.3 ～ 1 μ とさせて S 3 の導電率を向上させることはマトリックス化に有効であった。

また第2図(B)において側面は基板(1)表面上に垂直に形成してもよいが、台形上にテープエッチをしてさらに積層されるゲート電極の段差部での段切を除去することは効果的であった。

さらに第2図(C)に示される如く、フォトリソグラフィー技術により S 1 を任意の所定形状を形成した。図面ではこのため(11)にて基板表面が露光させた。

さらにこの後この S 1 、 S 2 、 S 3 の表面全体に绝缘膜(6)を形成した。この绝缘膜は 13.56MHz ～ 2.45GHz の周波数の電磁エネルギーにより活性化して酸素または酸素と水素との混合気体雰囲気に 100 ～ 700 °C にて熱して酸化して形成した。

さらに L P C V D 法により窒化珪素またはリンガラスを形成させた多層構造としてもよい。

するとS2(14)の側周辺にはゲイト絶縁物(16)としてこの絶縁物(16)が形成され、S1、S3の表面はアイソレイション用被膜として形成させることができた。

さらに(D)に示される如く、第3のフォトリソグラフィー技術によりS1(12)に対し電極穴(8)をS3(15)に対し電極穴(7)を形成しゲート電極に連結する金属または半導体層を再度積層した。

次に第4のフォトリソグラフィー技術によりこの膜を選択的にエッチングして、ゲート電極(17)をゲート絶縁物(16)、(16')と2方向に設けて作り、同時にS1(12)、S3(15)より電極穴を介して他部のIGF、キャパシタ、抵抗へ基板表面または絶縁物(6)上に密接して配線させた。

第2図(D)のたて断面図のA-A'を横方向よりみると第2図(E)として示すことができる。番号はそれぞれ対応させている。

本発明の半導体は主としてSASを用い、その中の不対結合手の中和用に水素を用いており、かつ基板と半導体、電極リードが異種材料であり、

それらの熱膨張によるストレスを少なくするため、すべての処理を300~600°C以下好ましくは300°C以下でするとよかったです。

またゲート電極(17)をS1、S3と同一導電型の半導体およびそれにMo等の金属を二層構造とした多層配線構造でよい。

かくしてソースまたはドレインをS1(12)、チャネル形成領域(9)、(9')を有するS2(14)、ドレインまたはソースをS3(15)により形成せしめ、チャネル形成領域側面にはゲート絶縁物(16)、(16')その外側面にゲート電極(17)を設けた積層型のIGF(10)を作ることができた。

この発明においてチャネル長S2(14)の厚さで決められ、ここでは0.05~0.5μとした。それはSASの移動度が単結晶とは異なりその1/5~1/100しかないとため、チャネル長を短くしてIGFとしての特性を助長させることにある。

SASは電子のバルク移動度が100~500cm²V/Sと1/3~1/10であるのに対し、ホールのそれは5~100cm²V/Sと1/5~1/100である。しかしそれに

アモルファス珪素が電子0.1~10cm²V/S、ホールは0.01cm²V/S以下に比べて10~10³倍も長いことを考えると、本発明の半導体装置にマイクロクリスタル構造を有するSASを用いたことはきわめて重要なことである。

さらに本発明のIGFにおいて、電子移動度がホールに比べて単結晶の3倍よりも大きく5~100倍もあるためNチャネル型とするのがきわめて好ましかった。

そのためS2には不純物を表面部に添加しない真性半導体はN型であるためこれをP型として用いた。

第3図は他の本発明のIGFのたて断面図およびその製造工程を示したものである。

第3図(A)において基板(1)上にSASの珪素膜をS1(2)として形成させた。さらにフォトリソグラフィー技術により選択エッチングを行ない、基板(1)の一部(11)を露呈させた。

次にこのSASを結晶化するための光(レーザ)アーナー、熱アーナーまたはこれらを併用して

このSASを単結晶または多結晶構造に変成させた。加熱温度は基板材料での熱ストレスを防ぐため、700°C以下にさせた。

このS1(2)は基本的にはS2、S3とエッティングレートが変わればよい。このためS1はPまたはN型の酸素または窒素が添加されてSiO<sub>2-x</sub>(0.5<x<2)、Si<sub>1-x</sub>N<sub>x</sub>(1<x<4)の化学量論を有する真性または半導性を有する半導体であってもよい。

第3図(B)に示す如く、この後この上面にS2(4)を真性、N型またはP型でさらにS1と同一の導電型にS3(5)をPまたはN型に積層して同一反応炉により形成せしめた。

さらに第3図(C)に示す如く、このS2(4)、S3(5)を最適同一形状に選択的に他部を除去して形成し、S2(14)、S3(15)をS1(12)上に設けた。この後このS1、S2、S3上表面を酸化して絶縁膜(6)として設けた。この時S2(14)の側周辺はゲート絶縁膜(16)として設けられ、他部はアイソレイション膜として設けた。

次に第3のフォトリソグラフィー技術を用いて電極穴またはコンタクト部(7), (8)を用いてその全上表面に半導体または導体の膜を設けた。この膜を第4のフォトリソグラフィー技術により選択的に除去してS1(12)にはその他部への連続電極リード(22)を、S3(15)にはコンタクト(7)を介して同様の電極、リードを設け、またS2(14)の側周辺のチャネル形成領域(9), (9')の側面のゲート電極(16), (16')上にはゲート電極(17)を構成した。

このようにしてソースまたはドレインをS1(12)によりチャネル形成領域(9), (9')をS2(14)により、ドレインまたはソースをS3(15)により構成せしめた。ゲートはゲート絶縁物(16), (16')とゲート電極(17)よりなっている。このようにしてゲート電極を"1"、ソースまたはドレインを"1"とすると、チャネル形成領域を電流が流れオン状態を、またそれそれが一方または双方が"0"ならばオフ状態を作ることができた。

"1"はNチャネル型IGFでは正の0.5~10Vの電流を、"0"は0Vまたはスレッシュホールト電圧

以下の電流を意味する。

Pチャネル型のIGFはその電極の極性を変えればよい。これらの論理系は第1図、第2図においてもまた以下の第3図または本発明の実施例においても同様である。

また第1図の抵抗(70)は第2図(D), (E)および第3図(D)においてゲートに加える電圧に無関係にS2のバルク成分の抵抗率で決められる。すなわちゲート電極を設けない状態でS1, S2, S3を積層すればよい。またこの抵抗値はS2の抵抗率とその厚さ、基板上にしめる面積で設計仕様に従って決めればよい。

第1図のインバータ(60)においてドライバー(61)は第2図、第3図(D)とし、さらにそのロード(64)はS3(15)、S1(12)の一方とゲート電極(17)との連絡させるエンハンスマント型またはディプレッシャン型のIGFとした。

さらにこのインバータ(60)の出力は(62)よりなり、この基板上に離間して2つのIGFを積層して複合化すればよく、入力部はゲート電極(17)に

対応して設ければよい。

第4図(A)は他の本発明のたて断面図を示したものである。すなわち基板(1)にS1(12)、S2(14)、S3(15)およびゲート部がゲート絶縁物(16)、ゲート電極(17)によりなっているIGF(10)と、S1(12)でかつ電気系に連絡した他部はキャパシタの一方の電極(22)を有し、かつこの他部は液晶表示の一方の電極(32)をも構成させている。すなわちS1はふたつのキャパシタの一方の電極となっている。そしてそのひとつのキャパシタは蓄積容量を大きくとり液晶表示の表示時間を長くするために用いられている。

すなわち第1図において特定のIGFがオン状態となる時間が10~100n秒であっても、液晶パネルとキャパシタが直列に接続されているため液晶表示はその表示が1~1000msも有するいわゆる残光特性をもたしめることができた。このため蓄積(ストーレイジキャパシタ)が大きいと例えばTVのブラウン管に対応する平面パネルでの表示があざやかになり、かつ絵素の数が10<sup>4</sup>~10<sup>5</sup>

ケになり、それらをデジタル的にスキャンしても他の絵素に"0", "1"を表示しつづけることが可能になる。この蓄積容量の有効性は絵素の数が10ヶ以上になった際見ている人に目のつかれを覚えさせないために有効である。

またこの蓄積容量のキャパシタはゲート絶縁物(16)と同一材料としたことにより、同一バッジ式に何らかの新たな工程を必要とせず作ることができた。しかしこの容量を小面積で増加するため、酸化珪素ではなく窒化珪素、酸化タンタルその他強誘電体を用いてもよい。

本発明におけるS1(12)に電気的に接続されている他の電極(32)は電極穴(25)を介して設けられている。これらIGF(10)上にポリイミドまたはP1Q等の層間絶縁物を1~3μの厚さに設け、それを選択的にフォトリソグラフィー技術により設ければよい。この電極(32)がひとつの絵素の大きさを決定する。カリキュレータ等においては0.1~5mmまたはく形を有している。しかし第1図の如き走査型の方式において、1~50μ□をマ

トリックス状として500×500とした。液晶表示部(31)はこの基板上に半導体基板電極を設けた一方の極と他方をITO等の透明電極(27)を有するガラス板(28)とを1~20μmの間隔を有せしめて対応させそこに例えばネマチック型の液晶(26)を注入して設けた。

またディスプレーをカラー表示してもよい。さらに例えばこれらの要素が三重に重ね合わされてもよい。そして赤緑青の3つの要素を交互に配列せしめればよい。

第4図(A)が蓄積キャパシタと液晶キャパシタで等価回路にて示される液晶と並列に連結して設けたのに対し、第4図(B)は直列に設けたものである。

すなわちS1(12)に電気的に連結した一方の電極(22)上に誘電膜(23)、他方の電極(24)、さらにこの電極(24)に連結した第2の液晶キャパシタ(31)の一方の電極(32)が開口(25)を介して連結しており、この電極(32)に対応して透明電極による対抗電極(27)が液晶(26)の誘電体をはさんで設けられ

の熱エネルギーに対して安定なことは本発明の他の特徴である。

特にSASは10~100Åの大きなマイクロクリスタル構造の格子歪を有する非単結晶半導体であり、その製造には500KHz~3GHzの誘導エネルギーを使っても温度が300℃まで充分であり、加えてその電子・ホールの拡散長がアモルファス珪素の100~10<sup>3</sup>倍も大きいという物性的特性を有している。かかる非単結晶半導体を基板上に積層する構造により、IGFを設けたこと、加えてここを電流がたて方向に流れるためチャネル長が0.1~1μのマイクロチャネル型IGFを高精度のフォトリソグラフィー技術を用いずに作ることができる

ことがきわめて大きな特徴である。

さらに本発明においてIGFとしての特性はSASの特性にかんがみ、そのスレッシュホールト電圧(V<sub>th</sub>)は例えばドープをイオン注入法で行なうのではなく、S2に添加する不純物の添加量と加える高周波パワーにより制御する点も特徴である。

れる。

第4図(A)(B)で明らかな如く、本発明は基板(I)上に複数のIGFキャパシタ、抵抗または同時にサンドウイッチ構造として液晶表示の平面パネルを設けたことを特徴としている。

さらに図面より明らかな如く、上方よりの光照射に対して、IGF(10)に光が照射して0°状態のリークしてしまうことを防止するためこれを上方よりおおい、絶縁の一方の電極(32)を設けていることを他の特徴としている。

加えて従来と異なり、絶縁基板上に完全に他の絶縁とアイソレイトしてIGFを横層型に設けていることはきわめて大きな特徴であり、特にこの全行程を600℃以下特に300℃以下の温度で作ることが可能であることは、このパネルが大面積としても熱歪の影響を受けにくいという大きな特徴を有している。

加えて本発明に用いた半導体は非単結晶構造を中心としており、特にSASというアモルファスと単結晶との中間構造であって、かつ600℃まで

そのため耐圧20~30V、V<sub>th</sub>=-4~4Vを±0.2Vの範囲で制御できた。さらに周波数特性がチャネル長が0.1~1μのマイクロチャネルのため、これまでの単結晶型の絶縁ゲート型半導体装置の1/5~1/50を非単結晶半導体を用いたのにもかかわらず得ることができた。

また逆方向リークではあるが、第1図に示すようなS1とS2との間に窒化珪素を10~40Åの厚さに挿入することによりこのN~P接合またはP~N接合のリークは逆方向に10Vを加えても10mA以下であった。これは単結晶の逆方向リークに匹敵する好ましいものであった。

またS1に例えば酸素を10~30モル%添加すると、第3図に示した構造においては同様に逆方向にリークが少なく、無添加の場合に比べて1/10~1/10倍もリークが少なかった。このリークが少ないことが第1図のマトリックス構造を実施するときわめて有効であることは当然である。

さらにこの逆方向リークはこの横層型のS1、S2、S3とともにアモルファス珪素の半導体の

みで作った場合、逆方向バイアスを10V加えると1mA以上あったが、これをSASとするところまで下がった。それはS1、S3のPまたはN型の半導体におけるB、Pの不純物が置換型に配位し、そのイオン化率が単結晶と同じく4N以上となったことおよびその活性化エネルギーもアモルファスの場合の0.2~0.3eVより0.005~0.001eVと小さくなっていることによる。

このため一度配位した不純物が積層中にアウトディフュージョンせず結果として接合がきれいにできたことによる。

すなわち本発明は積層型IGFであること、そこに非単結晶半導体を用いたこと、特にSASを用いたこと、さらにS1とS2の間の接合を明確にするためS1に酸化珪素を同時に添加し主にエネルギーバンド幅として逆耐圧を上げたこと、または遮断または半绝缘膜を介在させたS1S接合としたことを特徴としている。

さらにかかる積層型のIGFのため従来のように高精度のフォトリソグラフィー技術を用いるこ

となる。基板特に绝缘基板上に複数個のIGF、抵抗、キャパシタを作ることが可能になった。そして液晶表示ディスプレーにまで発展させることができた。

本発明における半導体は珪素、绝缘体は酸化珪素または窒化珪素を用いた。しかし半導体としてゲルマニウム、InP、BP、GaAs等を用いてもよい。また非単結晶半導体ではなく単結晶半導体を、またSASではなくその結晶粒径の大きな多結晶半導体であってもよいことはいうまでもない。

#### 4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明による液晶電気光学装置に用いる绝缘ゲート型半導体装置、インバータ抵抗、キャパシタまたは绝缘ゲート型半導体装置とキャパシタとを絶縁としたマトリックス構造の等価回路を示す。

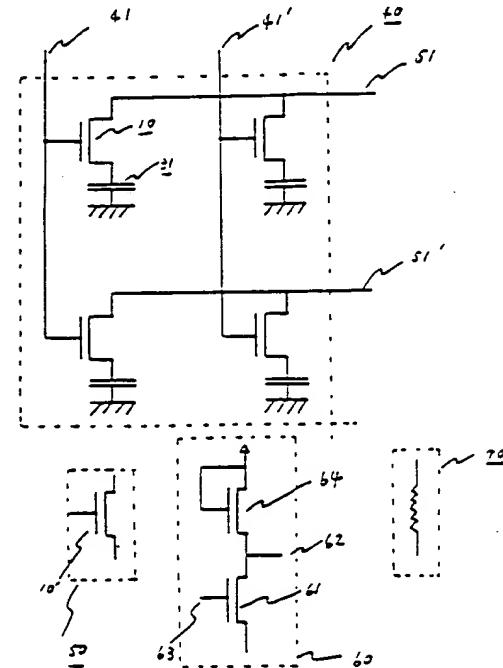
第2図、第3図は本発明による液晶電気光学装置に用いる積層型绝缘ゲート型半導体装置の工程を示すたて断面図である。

第4図は本発明の積層型绝缘ゲート型半導体装置とキャパシタまたは液晶とを一体化した平面ディスプレーを示す複合半導体のたて断面図である。

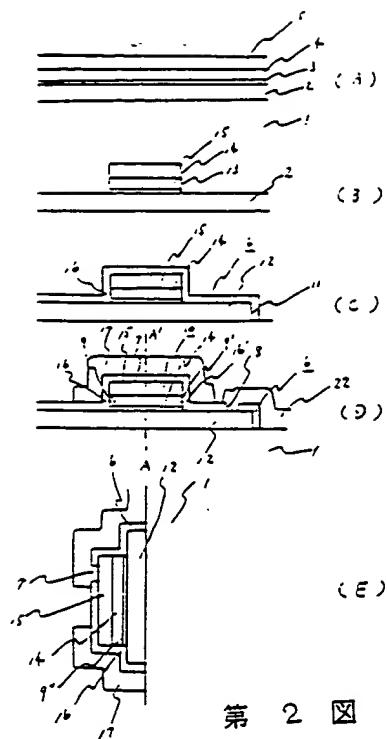
特許出願人

株式会社半導体エネルギー研究所

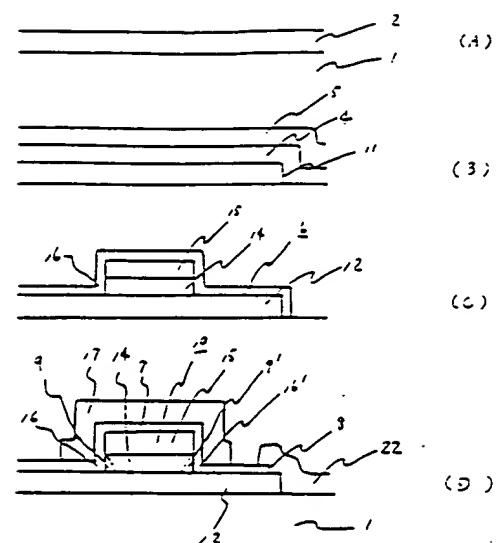
代表者 山崎昇平



第1図



第2図



第3図

